

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-176727

(43)Date of publication of application : 02.07.1999

(51)Int.Cl.

H01L 21 027
G01B 17 00
G03F 7 20

(21)Application number : 09-341445

(71)Applicant : NIKON CORP

(22)Date of filing : 11.12.1997

(72)Inventor : SHIRAISHI NAOMASA

(54) PROJECTION ALIGNER

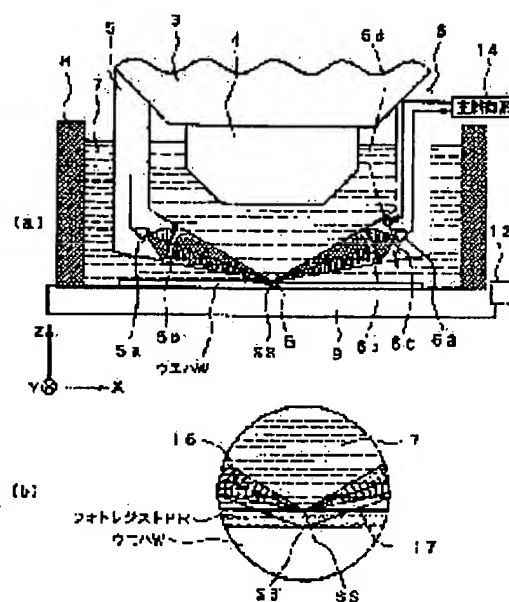
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To detect with high precision a position in an optical axis direction of a projection optical system on a surface of a substrate, even when wavelengths of aligned lights are substantially reduced and moreover the alignment is carried out in a liquid.

SOLUTION: A liquid 7 is supplied to a sidewall 8 so as to satisfy a gap between a lens 4 of a projection optical system which is closest to a wafer W and the wafer W.

Ultrasonic waves are emitted from an ultrasonic emission system 5, and the ultrasonic waves reflected by an ultrasonic focusing position SS are received by an ultrasonic reception system 6. Based on a detection signal from the ultrasonic reception system 6, a

defocusing amount from a best focusing position in a focusing position SS of ultrasonic waves is acquired. Based on the acquired defocusing amount, a sample ore pedestal 9 is driven in a Z-direction to control a focusing position.



* NOTICES

JP0 and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1 A projection aligner which transfers a mask pattern on a substrate via a projection optical system, comprising:

A dipping device which supplies a predetermined fluid to the surface of said substrate.

A surface position sensing device of an ultrasonic sensing method which detects a position of an optical axis direction of said projection optical system of said surface by detecting an ultrasonic wave which sends out an ultrasonic wave to the surface of said substrate via said fluid, and is reflected in it on said surface.

[Claim 2 The projection aligner according to claim 1 when photosensitive materials are applied to the surface of said substrate, wherein said surface position sensing device detects a position of an optical axis direction of said projection optical system of the surface of said photosensitive materials.

[Claim 3 Claim 1, wherein said fluid is supplied so that between a tip part of an optical element by the side of said substrate of said projection optical system and the surfaces of said substrate may be filled, or a projection aligner given in two.

[Claim 4 Claims 1 and 2, wherein said fluid is water or an organic solvent, or a projection aligner given in three.

[Claim 5 A projection aligner comprising of claim 1-4 given in any 1 paragraph:

A substrate stage which holds said substrate and positions this substrate on a flat surface vertical to an optic axis of said projection optical system.

A height control stage which controls a position of an optical axis direction of said projection optical system of said substrate based on a detection result of said surface position sensing device.

[Translation done.]

* NOTICES

JP0 and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention

[0001]

[Field of the Invention This invention relates to the projection aligner used for the lithography process for manufacturing a semiconductor device, a liquid crystal display element, or a thin film magnetic head, for example.

[0002]

[Description of the Prior Art When manufacturing a semiconductor device etc., the image of the pattern of the reticle as a photo mask via a projection optical system, Projection aligners, such as a stepper type transferred to each shot region on the wafers (or glass plate etc.) in which the resist as a substrate was applied, or a step and scanning method, are used.

[0003]The resolution of the projection optical system with which the projection aligner is equipped becomes so high that the exposure wavelength to be used is short and the numerical aperture of a projection optical system is large. Therefore, short wavelength formation of the exposure wavelength used with a projection aligner in connection with the minuteness making of an integrated circuit is carried out every year, and the numerical aperture of a projection optical system has also been increasing. And although a mainstream exposure wavelength is 248 nm of a KrF excimer laser, 193-nm use of the ArF excimer laser of short wavelength is also considered now.

[0004]When exposing, it becomes important the depth of focus like resolution. The resolution R and the depth of focus Δ are expressed with the following formulas, respectively.

$$R = k_1 \lambda / \text{NA} \quad (1)$$

$$\Delta = k_2 \lambda / \text{NA}^2 \quad (2)$$

Here, as for an exposure wavelength and NA, the numerical aperture of a projection optical

system, k_1 , and k_2 of λ are process coefficients. When obtaining the same resolution, the depth of focus [that it is bigger using the exposing light of short wavelength can be obtained. However, if the spectrum penetration characteristic of the penetrable optical member (** material) used for a projection optical system is taken into consideration, at present, the exposing light of the wavelength of an ArF excimer laser shorter than 193 nm can be penetrated, and there is almost no uniform ** material which can form a comparatively big lens.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention It is difficult like the above to use the exposing light of the wavelength of an ArF excimer laser shorter than 193 nm in the conventional projection aligner (projection optical system). Then, it is considered as the method of shortening an exposure wavelength substantially, and the immersion method is proposed. A wafer is dipped into a predetermined fluid, and this improves resolution using the wavelength of the exposing light in the inside of a fluid increasing $1/n$ time (n is usually 1.2 to about 1.6 at the refractive index of a fluid) in the air, and increases the depth of focus.

[0006]By the way, since the whole exposure ranges need to enter within the limits of the depth of focus of a projection optical system at the time of exposure, the focus mechanism (autofocusing mechanism) is formed in the projection aligner. An optical beam is entered into the surface of the wafer which should generally be exposed by oblique incidence, the catoptric light is received by the optical system of a confrontation, the focusing state of a wafer surface is detected, and this moves a wafer up and down, and drives in to a focusing position.

[0007]The film (photoresist) is applied to the wafer surface exposed, and a pattern is transferred by this photoresist. Then, it is desirable to coincide this photoresist surface with the focal position of a projection optical system, and it needs to detect ***** on the surface of photoresist. The space where a wafer is arranged is filled with the conventional projection aligner with gases, such as air or nitrogen. And the refractive index of air is 1, for example, and the refractive index of the photoresist applied to the wafer surface is about 1.7. Therefore, the reflectance of the light in an air-photoresist interface is calculated as follows than Fresnel's formulas.

$$\text{Reflectance} = \left\{ \frac{(1-1.7)}{(1+1.7)} \right\}^2 \times 100 = 6.7 \quad (3)$$

an air-photoresist interface -- the light flux for focus detection -- many reflect comparatively and the position on the surface of photoresist can be detected.

[0008]However, the space where a wafer is arranged will be filled with a fluid at the case of the projection aligner which adopted the immersion method. For example, when a fluid is water, the refractive index is 1.3 and the reflectance of the light in a water-photoresist interface is calculated as follows than Fresnel's formulas.

$$\text{Reflectance} = \left\{ \frac{(1.3-1.7)}{(1.3+1.7)} \right\}^2 \times 100 \approx 1.8 \quad (4)$$

In a water-photoresist interface, since the difference of the refractive index of space and photoresist becomes remarkably small compared with an air-photoresist interface, the reflectance of the light flux for focus detection falls, and it becomes difficult to detect the position on the surface of photoresist correctly.

[0009] This invention carries out short wavelength formation of the wavelength of exposing light in view of this point, and it aims at providing the projection aligner which can transfer a more detailed pattern. It aims also at providing the projection aligner which can detect the position of the optical axis direction of the projection optical system of the surface of the photosensitive materials with high precision, even if it is a case where exposure is performed on the substrate with which photosensitive materials were applied in the fluid.

[0010]

[Means for Solving the Problem] A projection aligner of this invention is characterized by that a projection aligner which transfers a pattern image of a mask (R) on a substrate (W) via a projection optical system (PL) comprises:

A dipping device which supplies a predetermined fluid (7) to the surface of the substrate (W) (2, 8).

A surface position sensing device of an ultrasonic sensing method which detects a position of an optical axis direction of the projection optical system (PL) of the surface by detecting an ultrasonic wave which sends out an ultrasonic wave to the surface of the substrate (W) via a fluid (7), and is reflected in it on the surface (5, 6).

[0011] According to the projection aligner of this invention, since a pattern image of a mask (R) is exposed on the surface of a substrate (W) via a fluid (7), the short wavelength formation of the wavelength of exposing light in a substrate face can be carried out $1/n$ time (n is a refractive index of a fluid (7)) of wavelength in the air. Since a surface position sensing device (5, 6) of an ultrasonic sensing method detects a position of an optical axis direction of the surface of a substrate (W) with high precision, in an optical surface position sensing device, the position is detectable with high precision in a fluid (7) with difficult detection of a surface position.

[0012] As for a surface position sensing device (5, 6), when photosensitive materials (PR) are applied on the surface of a substrate (W), it is desirable to detect a position of an optical axis direction of a projection optical system (3, 4) of the surface of the photosensitive materials (PR). In this case, the image surface of a projection optical system (3, 4) can be doubled with the surface of those photosensitive materials (PR). It is desirable to supply a fluid (7) so that between tip parts and the surfaces of a substrate (W) of an optical element (4) by the side of a substrate (W) of a projection optical system (PL) may be filled. In this case, the short

wavelength formation of the wavelength of exposing light in the substrate (W) surface can be carried out $1/n$ time (n is a refractive index of a fluid (7)) of wavelength of exposing light in the air. In order that a body tube (3) of a projection optical system (PL) may not contact a fluid (7), there is an advantage of becoming difficult to corrode a body tube (3).

[0013]The fluid (7) is water (refractive index 1.3) or organic solvents (for example, alcohol (ethanol (refractive index 1.36) etc.), cedarwood oil (refractive index 1.52), etc.). In this case, in using water as a fluid (7), there is an advantage that that acquisition is easy. In using an organic solvent as a fluid (7), there is an advantage of becoming difficult to corrode a body tube (3) of a projection optical system (PL). When using cedarwood oil as a fluid (7), the refractive index is as large as about 1.5, and short wavelength formation of the exposing light can be carried out more.

[0014]A substrate stage (10) which holds a substrate (W) and positions this substrate (W) on a flat surface vertical to an optic axis of a projection optical system (PL), It is desirable to have a height control stage (9) which controls a position of an optical axis direction (3, 4) of a projection optical system of the substrate (W) based on a detection result of a surface position sensing device (5, 6). In this case, the surface of a substrate (W) can be doubled with high precision to the image surface of a projection optical system (3, 4).

[0015]

[Embodiment of the Invention Hereafter, with reference to drawing 1 - drawing 3, it explains per example of an embodiment of the invention. In drawing 1 (a) shows the outline composition of the projection aligner of this example, and this drawing 1 (a), Exposing light IL which consists of ultraviolet pulsed light with a wavelength of 193 nm ejected from the illumination-light study system 1 containing the source of ArF excimer laser light as an exposure light source, an optical integrator, a field diaphragm, a condensing lens, etc. illuminates the pattern provided in the reticle R. the pattern of the reticle R -- a both-sides (or wafer side one side) call -- reduction projection is carried out in the exposure region on the wafer W in which the photoresist PR was applied via centric projection optical system PL with the predetermined projecting magnification beta (beta is $1/4$, and $1/5$ grades). As an exposing light IL, KrF excimer laser light (wavelength of 248 nm), F_2 excimer laser beam (wavelength of 157 nm), i line (wavelength of 365 nm) of a mercury lamp, etc. may be used. The Z-axis is taken in parallel with the optic axis AX of projection optical system PL hereafter, a Y-axis is taken in accordance with a direction vertical to the space of drawing 1 (a) in a flat surface vertical to the Z-axis, and the X-axis is taken and explained in accordance with a direction parallel to space.

[0016]The reticle R is held on the reticle stage RST, and the mechanism which can be moved slightly to the direction of X, the direction of Y, and a hand of cut is built into the reticle stage RST. The two-dimensional position of the reticle stage RST and the angle of rotation are measured by real time with the laser interferometer (un-illustrating). On the other hand, the

wafer W is held on the sample table 9 via a wafer holder (un-illustrating), and the sample table 9 is being fixed on Z stage 10 which controls the focusing position (position of a Z direction) and angle of inclination of the wafer W. The cylindrical side attachment wall 8 is established on the sample table 9, it is, and the inside is filled with the fluid 7. The fluid 7 is supplied in the side attachment wall 8 before exposure via the nozzle 2a by the fluid supply recovery system 2 which consists of pumps etc., and are collected after exposure. In the projection aligner of this example, since water (refractive index 1.3) is used as the fluid 7 and the wavelength of light increases 1/1.3 time in the air in underwater, short wavelength formation of the wavelength of the exposing light which consists of ArF excimer lasers (wavelength of 193 nm) is substantially carried out to about 148 nm.

[0017]The body tube 3 of projection optical system PL is metal, and it is using the contacting parts of projection optical system PL and the fluid 7 only as the lens 4 nearest to the wafer W in this example in order to prevent corrosion with the fluid 7. The focal position detection system (it calls the following "AF sensors 5 and 6") which consists of the ultrasonic ejection system 5 and the ultrasonic reception system 6 is attached to the side of the body tube 3 of projection optical system PL.

[0018]Drawing 1 (b) is an about eight side attachment wall [of drawing 1 (a)] enlarged drawing, and the door 8a which can be opened and closed and which is used in the case of conveyance of a up to the sample table 9 of the wafer W or taking out from the sample table 9 is formed in the side attachment wall 8 in this drawing 1 (b). The nozzle 2a of the fluid supply recovery system 2 has supply of a fluid, and composition which can be driven up and down in the case of recovery.

[0019]It returns to drawing 1 (a), Z stage 10 is fixed on XY stage 11 where it moves along an XY plane parallel to the image surface of projection optical system PL, and XY stage 11 is laid on the unillustrated base. Z stage 10 controls the focusing position (position of a Z direction) of the wafer W, and an angle of inclination, and the photoresist PR surface on the wafer W An autofocus method, And it doubles with the image surface of projection optical system PL by an auto leveling method, and XY stage 11 performs alignment of the direction of X of the wafer W, and the direction of Y. The two-dimensional position of the sample table 9 (wafer W) and the angle of rotation are measured by real time with the laser interferometer 13 as a position of the moving mirror 12. Based on this measuring result, control information is sent to the wafer stage drive system 15 from the main control system 14, operation of Z stage 10 and XY stage 11 is controlled, each shot region on the wafer W moves to an exposure position one by one at the time of exposure, and exposure transfer of the pattern of the reticle R is carried out to each shot region.

[0020]Next, AF sensors 5 and 6 of the projection aligner of this example are explained.

Drawing 2 (a) expands and shows the neighborhood of the lower part of the projection optical

system of this example, and the ultrasonic wave generation element 5a and the focussing-of-ultrasonic-waves element 5b are formed in the ultrasonic ejection system 5 in this drawing 2 (a). It converges on converging position SS on the photoresist PR surface applied to the wafer W by the focussing-of-ultrasonic-waves element 5b, it reflects by converging position SS, and an ultrasonic wave with a frequency of 50 MHz - about 200 MHz ejected from the ultrasonic wave generation element 5a which consists of piezoelectric elements etc. enters into the ultrasonic reception system 6. The ultrasonic wave receiving element 6a, the focussing-of-ultrasonic-waves element 6b, and the sound insulating board 6c that can vibrate are formed in the ultrasonic reception system 6, and the ultrasonic wave which entered into the ultrasonic reception system 6 converges by the focussing-of-ultrasonic-waves element 6b, and enters into the ultrasonic wave receiving element 6a via the opening of the sound insulating board 6c. The detecting signal of the ultrasonic wave receiving element 6a is supplied to the main control system 14. The opening which passes an ultrasonic wave is provided in the center section of the sound insulating board 6c, and the position from which the main control system 14 carries out the horizontal shift (or vibration) of the sound insulating board 6c with the sound insulating board drive mechanism 6d, and the detecting signal of the ultrasonic wave receiving element 6a becomes the maximum is detected. Or synchronous detection of the detecting signal of the ultrasonic wave receiving element 6a may be carried out by the signal which synchronized with vibrating the sound insulating board 6c.

[0021]Drawing 2 (b) expands and shows near converging position SS of the ultrasonic wave on the photoresist PR surface, and the photoresist PR for sensitization is applied on the wafer W in this drawing 2 (b). Even if the AF sensor of an oblique incidence method tends to detect position SS on the photoresist PR surface by the conventional optical type, In order the refractive index of the fluid 7 and the photoresist PR is comparable, and reflectance becomes very low and to follow light to the surface of the wafer W in accordance with the course 17, position SS' detected is not located on the surface of the photoresist PR, but the surface of the substrate of the wafer W itself doubles with the image surface of projection optical system PL. Since the ultrasonic wave of AF sensors 5 and 6 of this example progresses in accordance with the course 16 and is reflected on the surface of the photoresist PR, position SS on the photoresist PR surface is detected correctly, and can make the photoresist PR surface focus to the image surface with high precision.

[0022]The position of the Z direction of the photoresist PR surface is detected from the horizontal shift amount of the converging position of the ultrasonic wave on the ultrasonic wave receiving element 6a by the same principle as the AF sensor of an oblique incidence method by the conventional optical type. Namely, if the wafer W shifts down in drawing 2 (b)] (- Z direction), the converging position on the ultrasonic wave receiving element 6a of drawing 2 (a) will shift up, If the wafer W shifts above in drawing 2 (b)], since the converging position on

the ultrasonic wave receiving element 6a shifts caudad, it can calculate the variation of the focusing position of the surface of the photoresist PR from this horizontal shift amount. Therefore, beforehand, best focus positions are defined with the test print etc., and should just double the center (or oscillating center) of the opening of the sound insulating board 6c, and the center of the converging position of an ultrasonic wave then.

[0023]Drawing 3 shows the relation of focusing signal D and focusing position Z of the photoresist PR surface which are produced by carrying out synchronous detection of the detecting signal from the ultrasonic reception system 6 as an example. Within the main control system 14, focusing signal D which changes in proportion almost to focusing position Z in a prescribed range is generated corresponding to converging position SS of the ultrasonic wave in the photoresist PR surface by detecting synchronously the detecting signal from the ultrasonic reception device 6a with the driving signal of the sound insulating board 6c. In this example, focusing signal D corresponding to converging position SS of an ultrasonic wave, The calibration is performed so that it may be set to 0, when converging position SS has agreed in the image surface (best focus positions) of projection optical system PL, and as for the main control system 14, a defocusing amount (the amount of gaps) can be calculated from focusing signal D. When the focusing position of the wafer W is up, Z stage 10 (wafer W) is moved caudad, and when there is a focusing position caudad conversely, it will expose by moving Z stage 10 (wafer W) up.

[0024]Although water (refractive index 1.3) was used as the fluid 7 in this example, organic solvents (for example, alcohol, cedarwood oil, etc.) can also be used as the fluid 7. In this case, there is an advantage of becoming difficult to corrode the body tube 3 of projection optical system PL. When using cedarwood oil (refractive index 1.5), the refractive index is as large as 1.5, and short wavelength formation of the exposing light can be carried out more substantially.

[0025]The sound insulating board which has two or more openings in the ultrasonic ejection system 5 about detection of a focusing position is arranged, It may be made to detect each focusing position of the two or more on the surface of photoresist, Or the sound insulating board which arranges the sound insulating board which has a big opening in the ultrasonic ejection system 5, and has two or more openings is arranged in the ultrasonic reception system 6, and it may be made to detect each focusing position in two or more points similarly.

[0026]In the above-mentioned embodiment, although the focusing position on the surface of photoresist of a wafer was detected using the ultrasonic wave, the leveling sensor which detects the angle of inclination on the surface of photoresist using an ultrasonic wave may be used. What is necessary is to irradiate with the ultrasonic wave which progresses almost in parallel on the surface of a wafer, and just to detect the sound-collecting position of the ultrasonic wave reflected in this leveling sensor.

[0027]Of course, various composition can be taken in the range which this invention is not limited to an above-mentioned embodiment, and does not deviate from the gist of this invention.

[0028]

[Effect of the Invention According to the projection aligner of this invention, since the pattern image of a mask is exposed on the surface of a substrate via a fluid, short wavelength formation of the wavelength of the exposing light in a substrate face can be substantially made twice [reciprocal] the refractive index of the fluid of the wavelength in the air. Since the surface position sensing device of an ultrasonic sensing method detects the position of the optical axis direction of a substrate face, in an optical surface position sensing device, the position is detectable with high precision in a fluid with difficult detection of a surface position.

[0029]When a surface position sensing device detects the position of the optical axis direction of the projection optical system of the surface of photosensitive materials, based on the detection information, the surface of the photosensitive materials can be doubled with high precision to the image surface of a projection optical system. When a fluid is supplied so that between the tip parts and the surfaces of a substrate of the optical element by the side of the substrate of a projection optical system may be filled, The short wavelength formation of the exposing light can be carried out $1/n$ time (n is a refractive index of a fluid) in the air, and in order that the body tube of a projection optical system may not contact a fluid, there is an advantage of becoming difficult to corrode the body tube of a projection optical system.

[0030]When a fluid is water, there is an advantage that the acquisition is easy. When fluids are organic solvents (for example, alcohol, cedarwood oil, etc.), there is an advantage of being hard to corrode the body tube of a projection optical system. When using cedarwood oil as a fluid, the refractive index is large compared with 1.5, water (refractive index 1.3), etc., and short wavelength formation of the exposing light can be carried out more.

[0031]The substrate stage which holds a substrate and positions this substrate on a flat surface vertical to the optic axis of a projection optical system, When it has a height control stage which controls the position of the optical axis direction of the projection optical system of the substrate based on the detection result of a surface position sensing device, the image surface of a projection optical system can be doubled with the exposure position on a substrate face.

[Translation done.]

* NOTICES

JP0 and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings

[Drawing 1 The outline lineblock diagram in which (a) shows the projection aligner of an example of an embodiment of the invention, and (b) are the enlarged drawings showing about eight side attachment wall of drawing 1 (a).

[Drawing 2 The elements on larger scale in which (a) shows the composition of the projection aligner lower part of drawing 1 (a), and (b) are the enlarged drawings of the B section of drawing 2 (a).

[Drawing 3 It is a figure showing the relation between focusing position Z on the surface of photoresist on the wafer W, and focusing signal D.

[Description of Notations

W Wafer

R Reticle

PL Projection optical system

1 Illumination-light study system

2 Fluid supply recovery system

3 Body tube

4 Lens

5 Ultrasonic ejection system

6 Ultrasonic reception system

7 Fluid

8 Side attachment wall

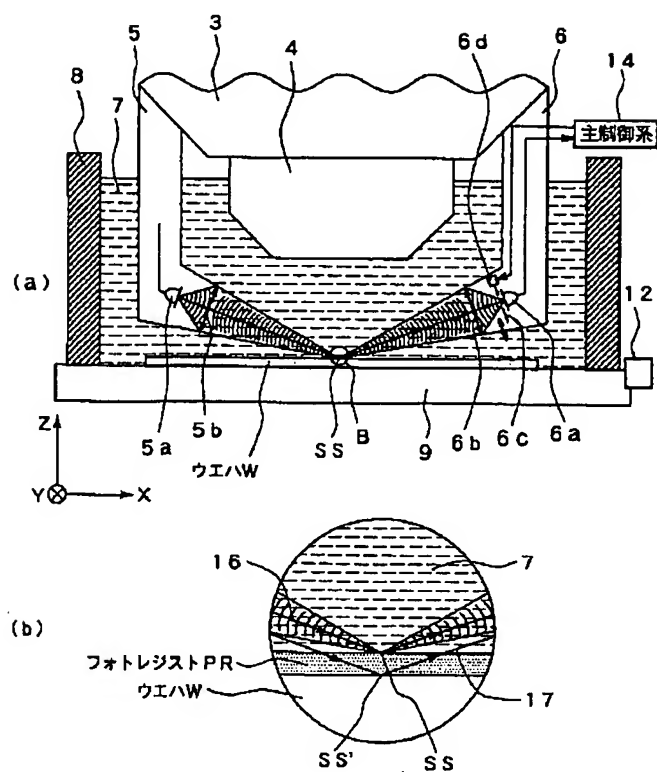
9 Sample table

10 Z stage

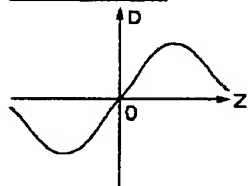
14 Main control system

15 Wafer stage drive system

[Translation done.]



[Drawing 3]



[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-176727

(43) 公開日 平成11年(1999) 7月2日

(51) Int.Cl.⁸ 識別記号
 H 0 1 L 21/027
 G 0 1 B 17/00
 G 0 3 F 7/20 5 2 1

F I
 H 0 1 L 21/30 5 2 6 Z
 G 0 1 B 17/00 B
 G 0 3 F 7/20 5 2 1
 H 0 1 L 21/30 5 1 4 C

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平9-341445

(22) 出願日 平成9年(1997)12月11日

(71) 出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72) 発明者 白石 直正

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

式会社ニコン内

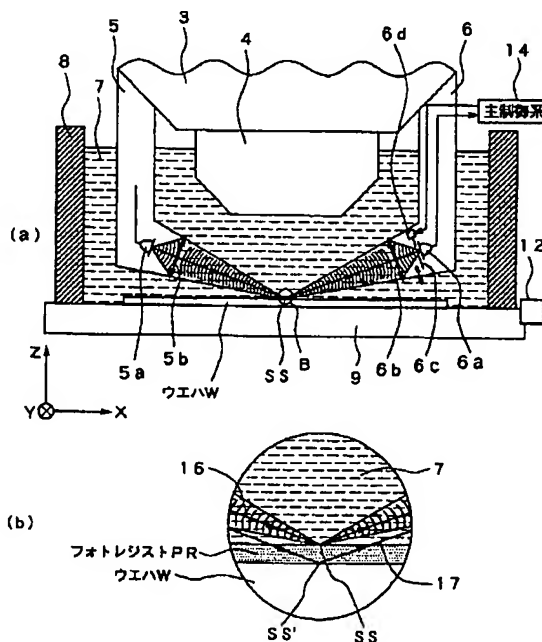
(74) 代理人 弁理士 大森 聡

(54) 【発明の名称】 投影露光装置

(57) 【要約】

【課題】 露光光を実質的に短波長化し、また、露光が液体中で行われる場合であっても、基板表面の投影光学系の光軸方向の位置を高精度に検出する。

【解決手段】 ウエハWに最も近い投影光学系のレンズ4とウエハWとの間を満たすように側壁8内に液体7を供給する。超音波射出系5から超音波を射出し、超音波集束位置SSにおいて反射した超音波を超音波受信系6により受信する。超音波受信系6からの検出信号に基づいて、超音波の集束位置SSにおけるベストフォーカス位置からのデフォーカス量を求める。求められたデフォーカス量に基づいて試料台9をZ方向に駆動し、フォーカス位置の制御を行う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 マスクパターンを投影光学系を介して基板上に転写する投影露光装置において、
前記基板の表面に所定の液体を供給する液浸装置と、
前記基板の表面に前記液体を介して超音波を送出し、前記表面で反射される超音波を検出することによって前記表面の前記投影光学系の光軸方向の位置を検出する超音波方式の面位置検出装置と、
を備えたことを特徴とする投影露光装置。

【請求項2】 前記基板の表面に感光材料が塗布されている際に、
前記面位置検出装置は、前記感光材料の表面の前記投影光学系の光軸方向の位置を検出することを特徴とする請求項1記載の投影露光装置。

【請求項3】 前記投影光学系の前記基板側の光学素子の先端部と前記基板の表面との間を満たすように前記液体が供給されることを特徴とする請求項1、又は2記載の投影露光装置。

【請求項4】 前記液体は、水、又は有機溶媒であることを特徴とする請求項1、2、又は3記載の投影露光装置。

【請求項5】 前記基板を保持して該基板を前記投影光学系の光軸に垂直な平面上で位置決めする基板ステージと、
前記面位置検出装置の検出結果に基づいて前記基板の前記投影光学系の光軸方向の位置を制御する高さ制御ステ

$$R = k_1 \cdot \lambda / NA$$

$$\delta = k_2 \cdot \lambda / NA^2$$

ここで、 λ は露光波長、 NA は投影光学系の開口数、 k_1 、 k_2 はプロセス係数である。同じ解像度を得る場合には短い波長の露光光を用いた方が大きな焦点深度を得ることができる。しかしながら、投影光学系に使用される透過性の光学部材（硝材）の分光透過特性を考慮すると、現時点ではArFエキシマレーザの193nmより短い波長の露光光を透過できると共に、比較的大きなレンズを形成できる均一な硝材はほとんどない。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】上記の如く従来の投影露光装置（投影光学系）では、ArFエキシマレーザの193nmより短い波長の露光光を使用することは困難である。そこで、実質的に露光波長を短くする方法として、液浸法が提案されている。これは、ウエハを所定の液体中に浸し、液体中での露光光の波長が、空気中の1/n倍（nは液体の屈折率で通常1.2～1.6程度）になることを利用して解像度を向上し、焦点深度を増大するというものである。

【0006】ところで、露光時には、露光範囲全体が投

$$\begin{aligned} \text{反射率} &= \{ (1 - 1.7) / (1 + 1.7) \}^2 \times 100 \\ &= 6.7 (\%) \end{aligned}$$

空気-フォトレジスト界面では、合焦検出用の光束の比

ーじと、を備えたことを特徴とする請求項1～4の何れか一項記載の投影露光装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、半導体素子、液晶表示素子、又は薄膜磁気ヘッド等を製造するためのリソグラフィ工程に用いられる投影露光装置に関する。

【0002】

【従来の技術】半導体素子等を製造する際に、フォトマスクとしてのレチクルのパターンの像を投影光学系を介して、基板としてのレジストが塗布されたウエハ（又はガラスプレート等）上の各ショット領域に転写するステッパー型、又はステップ・アンド・スキャン方式等の投影露光装置が使用されている。

【0003】投影露光装置に備えられている投影光学系の解像度は、使用する露光波長が短く、投影光学系の開口数が多いほど高くなる。そのため、集積回路の微細化に伴い投影露光装置で使用される露光波長は年々短波長化しており、投影光学系の開口数も増大してきている。そして、現在主流の露光波長は、KrFエキシマレーザの248nmであるが、更に短波長のArFエキシマレーザの193nmの使用も検討されている。

【0004】また、露光を行う際には、解像度と同様に焦点深度も重要となる。解像度R、及び焦点深度 δ はそれぞれ以下の式で表される。

$$(1)$$

$$(2)$$

投影光学系の焦点深度の範囲内に入る必要があるため、投影露光装置には、合焦機構（オートフォーカス機構）が設けられている。これは、一般に露光すべきウエハの表面に斜入射で光ビームを入射し、その反射光を対面の光学系で受光してウエハ表面の合焦状態を検出し、ウエハを上下に移動して合焦位置へ追い込むというものである。

【0007】露光されるウエハ表面には感光膜（フォトレジスト）が塗布されており、このフォトレジストにパターンが転写される。そこで、このフォトレジスト表面を投影光学系の焦点位置に一致させることが望ましく、フォトレジスト表面の位置を検出する必要がある。従来の投影露光装置では、ウエハが配置される空間は空気、又は窒素等の気体で満たされている。そして、例えば空気の屈折率は1であり、ウエハ表面に塗布されたフォトレジストの屈折率は、約1.7である。従って、空気-フォトレジスト界面における光の反射率は、フレネルの式より以下のように計算される。

$$(3)$$

較的多くが反射し、フォトレジスト表面の位置を検出す

ることができる。

【0008】しかし、液浸法を採用した投影露光装置の場合には、ウエハが配置される空間は液体で満たされる

$$\text{反射率} = \left\{ (1.3 - 1.7) / (1.3 + 1.7) \right\}^2 \times 100 \\ = 1.8 (\%)$$

水-フォトレジスト界面では、空気-フォトレジスト界面に比べ空間とフォトレジストとの屈折率の差が著しく小さくなるため、合焦検出用の光束の反射率が低下し、フォトレジスト表面の位置を正確に検出することが困難となる。

【0009】本発明は斯かる点に鑑み、露光光の波長を短波長化し、より微細なパターンを転写できる投影露光装置を提供することを目的とする。さらに、液体中で感光材料が塗布された基板上に露光が行われる場合であっても、その感光材料の表面の投影光学系の光軸方向の位置を高精度に検出することができる投影露光装置を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明の投影露光装置は、マスク(R)のパターン像を投影光学系(PL)を介して基板(W)上に転写する投影露光装置において、その基板(W)の表面に所定の液体(7)を供給する液浸装置(2, 8)と、その基板(W)の表面に液体(7)を介して超音波を送出し、その表面で反射される超音波を検出することによってその表面のその投影光学系(PL)の光軸方向の位置を検出する超音波方式の面位置検出装置(5, 6)とを備えたものである。

【0011】斯かる本発明の投影露光装置によれば、マスク(R)のパターン像を液体(7)を介して基板(W)の表面に露光するため、基板表面における露光光の波長を空気中における波長の $1/n$ 倍(n は液体(7)の屈折率)に短波長化できる。また、超音波方式の面位置検出装置(5, 6)により基板(W)の表面の光軸方向の位置を高精度に検出するため、光学式の面位置検出装置では面位置の検出が困難な液体(7)中においても、その位置を高精度に検出することができる。

【0012】また、基板(W)の表面に感光材料(PR)が塗布されている際に、面位置検出装置(5, 6)は、その感光材料(PR)の表面の投影光学系(3, 4)の光軸方向の位置を検出することが望ましい。この場合、投影光学系(3, 4)の像面をその感光材料(PR)の表面に合わせ込むことができる。また、投影光学系(PL)の基板(W)側の光学素子(4)の先端部とその基板(W)の表面との間を満たすように液体(7)が供給されることが望ましい。この場合、基板(W)表面における露光光の波長を、空気中における露光光の波長の $1/n$ 倍(n は液体(7)の屈折率)に短波長化できる。さらに、投影光学系(PL)の鏡筒(3)が液体(7)に接触しないため、鏡筒(3)が腐食しにくくなるという利点がある。

ことになる。例えば液体が水である場合、その屈折率は1.3であり、水-フォトレジスト界面における光の反射率は、フレネルの式より以下のように計算される。

(4)

【0013】また、その液体(7)は、水(屈折率1.3)、又は有機溶媒(例えばアルコール(エタノール(屈折率1.36)等)、セダー油(屈折率1.52)等)である。この場合に液体(7)として水を用いる場合には、その入手が容易であるという利点がある。また、液体(7)として有機溶媒を用いる場合には、投影光学系(PL)の鏡筒(3)が腐食しにくくなるという利点がある。さらに、液体(7)としてセダー油を用いる場合には、その屈折率が約1.5と大きく、露光光をより短波長化することができる。

【0014】また、基板(W)を保持してこの基板(W)を投影光学系(PL)の光軸に垂直な平面上で位置決めする基板ステージ(10)と、面位置検出装置(5, 6)の検出結果に基づいてその基板(W)の投影光学系の光軸方向(3, 4)の位置を制御する高さ制御ステージ(9)とを備えることが望ましい。この場合、投影光学系(3, 4)の像面に対して基板(W)の表面を高精度に合わせ込むことができる。

【0015】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態の一例につき図1～図3を参照して説明する。図1(a)は本例の投影露光装置の概略構成を示し、この図1(a)において、露光光源としてのArFエキシマレーザ光源、オプティカル・インテグレータ、視野絞り、コンデンサレンズ等を含む照明光学系1から射出された波長193nmの紫外パルス光よりなる露光光ILは、レチクルRに設けられたパターンを照明する。レチクルRのパターンは、両側(又はウエハ側に片側)テレセントリックな投影光学系PLを介して所定の投影倍率 β (β は例えば $1/4$ 、 $1/5$ 等)でフォトレジストPRが塗布されたウエハW上の露光領域に縮小投影される。なお、露光光ILとしては、KrFエキシマレーザ光(波長248nm)、F₂エキシマレーザ光(波長157nm)や水銀ランプのi線(波長365nm)等を使用してもよい。以下、投影光学系PLの光軸AXに平行にZ軸を取り、Z軸に垂直な平面内で図1(a)の紙面に垂直な方向に沿ってY軸を取り、紙面に平行な方向に沿ってX軸を取って説明する。

【0016】レチクルRはレチクルステージRST上に保持され、レチクルステージRSTにはX方向、Y方向、回転方向に微動できる機構が組み込まれている。レチクルステージRSTの2次元的な位置、及び回転角はレーザ干渉計(不図示)によってリアルタイムに計測されている。一方、ウエハWはウエハホルダ(不図示)を介して試料台9上に保持され、試料台9はウエハWのフ

ォーカス位置（Z方向の位置）及び傾斜角を制御するZステージ10上に固定されている。試料台9上には円筒状の側壁8が設けられ、その内部は液体7で満たされている。液体7は、ポンプ等からなる液体供給回収系2により、ノズル2aを介して露光前に側壁8内に供給され、露光後に回収される。なお、本例の投影露光装置では液体7として水（屈折率1.3）を使用しており、光の波長は水中において空気中の1/1.3倍になるため、ArFエキシマレーザ（波長193nm）よりなる露光光の波長は実質的に約148nmに短波長化される。

【0017】また、投影光学系PLの鏡筒3は金属製であり、液体7による腐食を防止するため、本例では、投影光学系PLと液体7との接触部分は、ウェハWに最も近いレンズ4のみとしている。また、投影光学系PLの鏡筒3の側面には、超音波射出系5と超音波受信系6とよりなる焦点位置検出系（以下「AFセンサ5, 6」と呼ぶ）が取り付けられている。

【0018】図1（b）は図1（a）の側壁8近傍の拡大図であり、この図1（b）において、側壁8にはウェハWの試料台9上への搬送、又は試料台9からの搬出の際に使用する開閉自在の扉8aが設けられている。また、液体供給回収系2のノズル2aは、液体の供給、及び回収の際に上下に駆動することができる構成となっている。

【0019】図1（a）に戻り、Zステージ10は投影光学系PLの像面と平行なXY平面に沿って移動するXYステージ11上に固定され、XYステージ11は不図示のベース上に載置されている。Zステージ10は、ウェハWのフォーカス位置（Z方向の位置）、及び傾斜角を制御してウェハW上のフォトレジストPR表面をオートフォーカス方式、及びオートレベリング方式で投影光学系PLの像面に合わせ込み、XYステージ11はウェハWのX方向、及びY方向の位置合わせを行う。試料台9（ウェハW）の2次元的な位置、及び回転角は、移動鏡12の位置としてレーザ干渉計13によってリアルタイムに計測されている。この計測結果に基づいて主制御系14からウェハステージ駆動系15に制御情報が送られ、Zステージ10、XYステージ11の動作が制御され、露光時にはウェハW上の各ショット領域が順次露光位置に移動し、レチクルRのパターンが各ショット領域へ露光転写される。

【0020】次に、本例の投影露光装置のAFセンサ5, 6について説明する。図2（a）は、本例の投影光学系の下部近傍を拡大して示し、この図2（a）において、超音波射出系5には超音波発生素子5a、及び超音波集束素子5bが設けられている。圧電素子等からなる超音波発生素子5aから射出された周波数50MHz～200MHz程度の超音波は、超音波集束素子5bによりウェハWに塗布されたフォトレジストPR表面上の集

束位置SSに集束され、集束位置SSで反射して超音波受信系6に入射する。超音波受信系6には超音波受信素子6a、超音波集束素子6b、及び振動できる遮音板6cが設けられており、超音波受信系6に入射した超音波は超音波集束素子6bにより集束され、遮音板6cの開口を介して超音波受信素子6aに入射する。超音波受信素子6aの検出信号は主制御系14に供給される。なお、遮音板6cの中央部には超音波を通過させる開口が設けられて、主制御系14が遮音板駆動機構6dにより遮音板6cを横シフト（又は振動）させて超音波受信素子6aの検出信号が最大になる位置を検出する。又は、遮音板6cを振動させるのに同期した信号で超音波受信素子6aの検出信号を同期検波してもよい。

【0021】図2（b）は、フォトレジストPR表面上の超音波の集束位置SS付近を拡大して示し、この図2（b）において、ウェハW上には感光用のフォトレジストPRが塗布されている。従来の光学式で斜入射方式のAFセンサによりフォトレジストPR表面上の位置SSを検出しようとしても、液体7とフォトレジストPRの屈折率が同程度で反射率が極めて低くなり、光は経路17に沿ってウェハWの表面まで進むため、検出される位置SS'はフォトレジストPRの表面上に位置せず、投影光学系PLの像面にはウェハWの基板自体の表面が合わせ込まれる。本例のAFセンサ5, 6の超音波は経路16に沿って進みフォトレジストPRの表面で反射されるため、フォトレジストPR表面上の位置SSが正確に検出され、高精度にフォトレジストPR表面を像面に合焦させることができる。

【0022】また、フォトレジストPR表面のZ方向の位置は、従来の光学式で斜入射方式のAFセンサと同様の原理によって超音波受信素子6a上での超音波の集束位置の横シフト量から検出される。即ち、ウェハWが図2（b）中の下方（-Z方向）にずれば図2（a）の超音波受信素子6a上での集束位置が上方にずれ、ウェハWが図2（b）中の上方にずれば超音波受信素子6a上での集束位置は下方にずれるため、この横シフト量よりフォトレジストPRの表面のフォーカス位置の変化量を求めることができる。そのため、予めベストフォーカス位置はテストプリント等によって定めておき、そのときに遮音板6cの開口の中心（又は振動中心）と超音波の集束位置の中心とを合わせておけばよい。

【0023】図3は、一例として超音波受信系6からの検出信号を同期検波して得られるフォーカス信号DとフォトレジストPR表面のフォーカス位置Zとの関係を示す。主制御系14内で、超音波受信装置6aからの検出信号を、遮音板6cの駆動信号で同期整流することによって、フォトレジストPR表面での超音波の集束位置SSに対応して、フォーカス位置Zに所定範囲でほぼ比例して変化するフォーカス信号Dが生成される。本例では、超音波の集束位置SSに対応するフォーカス信号D

は、集束位置SSが投影光学系PLの像面（ベストフォーカス位置）に合致しているときに0になるようにキャリブレーションが行われており、主制御系14は、フォーカス信号Dよりデフォーカス量（ずれ量）を求めることができる。ウエハWのフォーカス位置が上方にある場合には、Zステージ10（ウエハW）を下方に移動し、逆にフォーカス位置が下方にある場合には、Zステージ10（ウエハW）を上方に移動して露光を行うことになる。

【0024】なお、本例では液体7として水（屈折率1.3）を使用した。液体7として有機溶媒（例えばアルコール、セダー油等）を用いることもできる。この場合には、投影光学系PLの鏡筒3が腐食しにくくなるという利点がある。また、セダー油（屈折率1.5）を用いる場合には、その屈折率が1.5と大きく、露光光を実質的により短波長化することができる。

【0025】なお、フォーカス位置の検出については、超音波射出系5に複数の開口を有する遮音板を配置し、フォトレジスト表面の複数点での各フォーカス位置を検出するようにしてもよく、あるいは、大きな開口を有する遮音板を超音波射出系5内に配置し、且つ複数の開口を有する遮音板を超音波受信系6内に配置して、同様に複数点での各フォーカス位置を検出するようにしてもよい。

【0026】なお、上記の実施の形態では、超音波を用いてウエハのフォトレジスト表面のフォーカス位置を検出したが、超音波を用いてフォトレジスト表面の傾斜角を検出するレベルセンサを用いてもよい。このレベルセンサでは、ウエハの表面にほぼ平行に進む超音波を照射して、反射される超音波の集音位置を検出すればよい。

【0027】なお、本発明は上述の実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の構成を取り得ることは勿論である。

【0028】

【発明の効果】本発明の投影露光装置によれば、マスクのパターン像を液体を介して基板の表面に露光するため、基板表面における露光光の波長を実質的に空気中における波長の液体の屈折率の逆数倍に短波長化できる。また、超音波方式の面位置検出装置により基板表面の光軸方向の位置を検出するため、光学式の面位置検出装置では面位置の検出が困難な液体中においても、その位置を高精度に検出することができる。

【0029】また、面位置検出装置が、感光材料の表面の投影光学系の光軸方向の位置を検出する場合には、その検出情報に基づいて投影光学系の像面に対してその感

光材料の表面を高精度に合わせ込むことができる。また、投影光学系の基板側の光学素子の先端部とその基板の表面との間を満たすように液体が供給される場合には、露光光を空気中の $1/n$ 倍（ n は液体の屈折率）に短波長化できる。また、投影光学系の鏡筒が液体に接触しないため、投影光学系の鏡筒が腐食しにくくなるという利点がある。

【0030】また、液体が、水である場合には、その入手が容易であるという利点がある。液体が、有機溶媒（例えばアルコール、セダー油等）である場合には、投影光学系の鏡筒が腐食しにくいという利点がある。さらに、液体としてセダー油を用いる場合には、その屈折率が1.5と水（屈折率1.3）等に比べて大きく、露光光をより短波長化することができる。

【0031】また、基板を保持してこの基板を投影光学系の光軸に垂直な平面上で位置決めする基板ステージと、面位置検出装置の検出結果に基づいてその基板の投影光学系の光軸方向の位置を制御する高さ制御ステージとを備える場合には、投影光学系の像面を基板表面上の露光位置に合わせ込むことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】（a）は本発明の実施の形態の一例の投影露光装置を示す概略構成図、（b）は図1（a）の側壁8近傍を示す拡大図である。

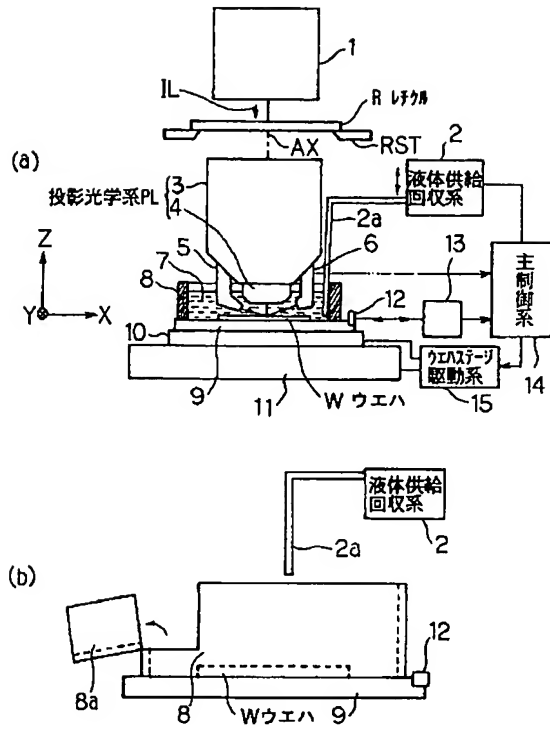
【図2】（a）は図1（a）の投影露光装置下部の構成を示す部分拡大図、（b）は図2（a）のB部の拡大図である。

【図3】ウエハW上のフォトレジスト表面のフォーカス位置Zとフォーカス信号Dとの関係を示す図である。

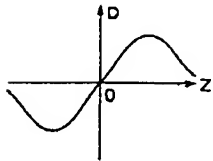
【符号の説明】

- W ウエハ
- R レチクル
- PL 投影光学系
- 1 照明光学系
- 2 液体供給回収系
- 3 鏡筒
- 4 レンズ
- 5 超音波射出系
- 6 超音波受信系
- 7 液体
- 8 側壁
- 9 試料台
- 10 Zステージ
- 14 主制御系
- 15 ウエハステージ駆動系

【図1】



【図3】



【図2】

